

Nachruf auf Harald Overhof

Am 5. Oktober 2005 ist Harald Overhof nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von nur 63 Jahren gestorben. Die schwere Krankheit war ihm erst wenige Monate vor seinem Tod bekannt geworden, er hat sie mit bewundernswerter Ergebenheit ins Unvermeidliche und größtmöglicher Schonung seiner Kollegen und Freunde ertragen.

Harald Overhof wurde am 5. Juni 1942 in Berlin geboren. Er studierte Physik an der Universität Marburg, wo er sich bereits in seiner Diplomarbeit der theoretischen Festkörperphysik widmete. Dieser Fachrichtung ist er bis zu seinem Tode treu geblieben. Als Schüler von Professor Otfried Madelung promovierte er 1969 mit einer Arbeit über die elektronische KKR-Bandstruktur von Blei-Chalkoniden. Nach seiner Rückkehr von einem zweijährigen Forschungsaufenthalt am IBM Almaden Research Center in San José begann er, sich mit einem seiner späteren Hauptarbeitsgebiete, dem Ladungstransport in amorphen Halbleitern, zu beschäftigen. Er habilitierte sich 1974 an der Universität Marburg mit seiner Schrift über „Variable Range Hopping Conduction in Amorphous Semiconductors“, einem Thema, das ihn noch lange weiter beschäftigen sollte. Nicht zuletzt durch das gemeinsam mit Peter Thomas verfasste Buch „Electronic Transport in Hydrogenated Amorphous Semiconductors“ (1989) ist der Name von Harald Overhof untrennbar mit dem Verständnis der Hopping-Leitfähigkeit in amorphen Halbleitern verbunden.

1976 folgte Harald Overhof einem Ruf auf eine Professur an der Technischen Universität in Berlin, doch schon drei Jahre später wechselte er als Professor für theoretische Physik an die kurz zuvor neu gegründete Universität Paderborn. Schon nach kurzer Zeit ergab sich dort, ganz im Sinne der Schule Otfried Madelungs, ein immer enger werdender Kontakt mit den experimentell in Paderborn arbeitenden Festkörperphysikern, welche Störstellen in Halbleitern und Isolatoren mit verschiedenen Methoden der magnetischen Resonanz und optischen Spektroskopie untersuchten.

Starthilfe für das gemeinsame Vorhaben, die elektronische Struktur dieser Störstellen mit Hilfe Green-scher Funktionen-Methoden zu berechnen, gab eine Zusammenarbeit mit Mattias Scheffler, der damals an der PTB in Braunschweig war und bei dem Harald Overhof einige Zeit häufiger Gast war. So entstanden, basierend auf dem LMTO-ASA-Verfahren sowie der Dichtefunktional-



Harald Overhof

theorie, in rascher Folge viele Rechnungen zu tiefen Störstellen in Silizium und III-V-Halbleitern. Harald Overhofs Arbeiten gebührt dabei das große Verdienst, Methoden entwickelt zu haben, mit denen die Hyperfeinstruktur tiefer Störstellen genau vorhergesagt werden kann, sodass nicht nur ein quantitativer Vergleich mit dem experimentellen Ergebnis, sondern überhaupt erst deren zuverlässige Deutung möglich wird. So konnte Harald Overhof auch zeigen, dass zahlreiche frühere Strukturbestimmungen, die nur aufgrund der experimentellen Daten erfolgten, falsch waren, da die elektronische Struktur vieler Störstellen eben nicht ohne weiteres „naiven“ Vorstellungen entspricht. Seine methodischen Erkenntnisse hat er in dem Buch „Point Defects in Semiconductors and Insulators“ (gemeinsam mit J.-M. Spaeth, Springer 2003) niedergelegt.

Harald Overhof hat sich in Wissenschaftsorganisation und Gremien nie in den Vordergrund gedrängt, war aber dennoch immer bereit, auch unbeliebte Ämter zu übernehmen. Darin bestach er durch seine nüchterne, sachbezogene und menschliche Art. Prinzipienreiter war nicht seine Sache. Prinzipienreiter konnte er vielmehr oft mit einer hintergründig sarkas-

tischen Bemerkung entwaffnen. Unvergessen sind derlei Bemerkungen von ihm auch zu politischen Tagesthemen. Harald Overhof war kein Freund von aufwändigen Forschungsanträgen und hat sich stets mit einer kleinen Arbeitsgruppe begnügt. Er hatte nur wenige Schüler. Nicht nur diese, sondern all seine Studenten, hatten in ihm jedoch einen großartigen und engagierten Lehrer, der viel forderte, aber auch sehr viel gab. Am liebsten befasste er sich selbst mit physikalischen Fragestellungen und arbeitete an seinen Projekten. Eigentlich war er geradezu besessen von seiner Arbeit, übertroffen nur noch durch seine Liebe zu seiner Familie mit Kindern und Enkelkindern. Wissenschaftliche Diskussionen mit ihm waren immer ein großer Gewinn. Man konnte ungeniert „dumme Fragen“ stellen, ohne „bestraft“ zu werden, was die Unterzeichneten auch reichlich taten. Seine freundschaftliche und unkomplizierte Art, an Probleme heranzugehen, machte Mut und wird von uns allen jetzt, da er nicht mehr unter uns ist, sehr vermisst. Wir haben einen großartigen Freund und wunderbaren Kollegen allzu früh verloren. Die Lücke, die er hinterlässt, wird nicht zu füllen sein.

JOHANN-MARTIN SPAETH,
SIEGMUND GREULICH-WEBER
UND UWE GERSTMANN

Prof. Dr. Johann-Martin Spaeth und Prof. Dr. Siegmund Greulich-Weber, Fakultät für Naturwissenschaften, Department Physik, Experimentalphysik, Universität Paderborn; Dr. Uwe Gerstmann, Fakultät für Naturwissenschaften, Department Physik, Theoretische Physik, z. Zt. Institut de Minéralogie et de Physique des Milieux Condensés: Université Pierre et Marie Curie, Paris